

平成28年度第1次募集（平成27年10月入学含む）
新潟大学大学院自然科学研究科博士前期課程入学者選抜試験問題
一般入試

数理物質科学専攻

物理学

A1

専門科目（物理学）

注意事項

- 1 この問題冊子は、試験開始の合図があるまで開いてはならない。
- 2 問題冊子は、表紙を含めて全部で8ページある。
- 3 解答は、すべて解答用紙の指定された箇所に記入すること。
- 4 受験番号は、各解答用紙の指定された箇所に必ず記入すること。
- 5 解答時間は、180分である。
- 6 下書きは、問題冊子の余白を使用すること。

[1]

一様な磁束密度の中で運動する粒子のラグランジアン L が、次のように与えられている。

$$L = \frac{1}{2} m (\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) + \frac{1}{2} qB (xz + y\dot{y} - z\dot{x}) .$$

ここで m , q , B はそれぞれ、粒子の質量、粒子の電荷、磁束密度の大きさである。また、一般化座標の組 (x, y, z) は、デカルト座標系における粒子の位置座標であり、 $(\dot{x}, \dot{y}, \dot{z})$ は、粒子の速度ベクトル（位置座標の時間 t に関する微分）である。以下の問いに答えよ。

- (1) x , y , z に共役な一般化運動量 p_x , p_y , p_z をそれぞれ求めよ。
- (2) x , y , z に対するラグランジュの運動方程式をそれぞれ求めよ。
- (3) 磁束密度ベクトルの各成分 B_x , B_y , B_z をそれぞれ求めよ。
- (4) 粒子のエネルギー E を求めよ。
- (5) ラグランジュの運動方程式の解のうち、次の関係式を満たす解 $x(t)$, $y(t)$, $z(t)$ を考える。

$$x(t) + iz(t) = ir \exp \left[-i \left(\frac{qB}{m} t + \frac{\pi}{3} \right) \right] , \quad y(t) = \sqrt{x(t)^2 + z(t)^2} .$$

ここで $i = \sqrt{-1}$ は虚数単位、 r は正の定数である。このとき、時刻 $t = 0$ における粒子の速度ベクトルの各成分 $\dot{x}(0)$, $\dot{y}(0)$, $\dot{z}(0)$ をそれぞれ求めよ。

[2]

(I) 真空の誘電率, 透磁率をそれぞれ ϵ_0, μ_0 として以下の問いに答えよ。

- (1) 無限に長い直線上に, 一様な線密度 λ で電荷が分布している。このとき直線から距離 r の位置に生じる電場の大きさを求めよ。
- (2) 無限に長い直線状の導線に大きさ I の電流が流れている。このとき導線から距離 r の位置に生じる磁束密度の大きさを求めよ。

(II) 図1のように, x 軸上に置かれた無限に長い直線状の導線に, 大きさ I の電流が点Aから点Bの向きに流れている。 x 軸方向の単位ベクトルを e_x で表すと, 導線上の微小部分 dx を流れる電流が, そこからベクトル r だけ変位した点につくる磁束密度は次式で表される。

$$dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{e_x \times r}{|r|^3} dx.$$

ここで μ_0 は真空の透磁率である。いま, 導線から距離 l だけ離れた点Pでの磁束密度の大きさを考える。ただし $\angle PAB = \theta_1, \angle PBA = \theta_2$ である。以下の問いに答えよ。

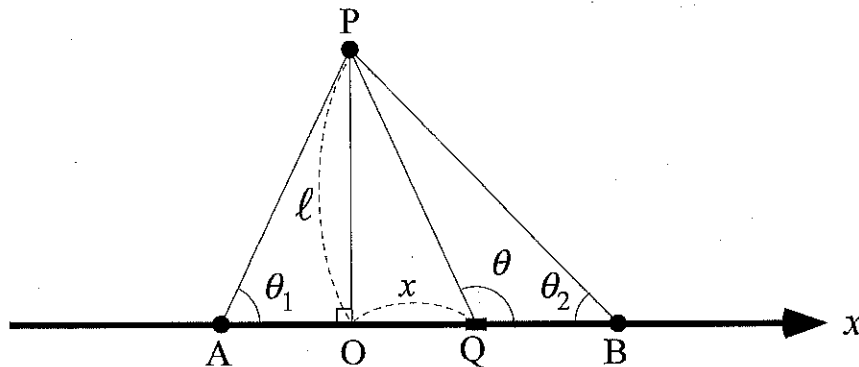


図 1:

- (1) 点Pから導線に垂線を下ろし, 導線との交点を原点Oとする。点Qの位置にある導線の微小部分 dx を流れる電流が点Pにつくる磁束密度の大きさを求めよ。ただし点Qの座標は x であり, $\angle PQA = \theta$ とする。

- (2) 導線の AB 間に流れる電流が点 P につくる磁束密度の大きさは、前問の結果を AB 間について積分することで得られる。この積分を θ について行い、AB 間の電流により点 P につくられる磁束密度の大きさ B が次式で表されることを示せ。

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi\ell} (\cos\theta_1 + \cos\theta_2)$$

- (Ⅲ) 図 2 のように、半径 a の円が内接する正 n 角形の形をした回路の導線に、大きさ I の電流が流れている。真空の透磁率を μ_0 として以下の問いに答えよ。必要ならば、(Ⅱ) で示された結果を用いてよい。

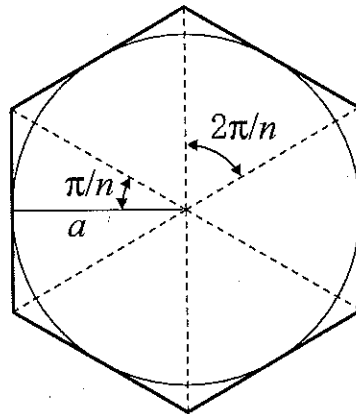


図 2: $n = 6$ の場合

- (1) 正方形 ($n = 4$) の場合、この回路の中心における磁束密度の大きさを求めよ。
- (2) 正 n 角形の場合、この回路の中心における磁束密度の大きさを求めよ。
- (3) 前問の結果において n を無限大にする極限をとると、 $B = \frac{\mu_0 I}{2a}$ となることを示せ。

[3]

一辺 L の正方形の底面をもつ直方体の箱があり、箱の上面は上下に動けるようになっている。図1のように、高さを z に固定した状態の箱に質量 m の単原子分子からなる古典理想気体を閉じ込め、その箱を温度 T の熱浴中に入れて系全体が熱平衡状態になるまで放置した。以下の問いに答えよ。なお必要ならば、問題文の最後にある数学公式を用いてよい。

- (1) 1 個の気体分子の運動エネルギーは、運動量 p を用いて $E_1 = \frac{p^2}{2m}$ と表される。カノニカル分布を用い、閉じ込められている気体分子 1 個の分配関数が

$$Z_1 = V \left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2} \right)^{3/2}$$

となることを説明せよ。ここで、 k_B はボルツマン定数、 h はプランク定数、 $V = L^2 z$ である。

- (2) N 個の気体分子の運動エネルギーは $E_N = \sum_{i=1}^N \frac{p_i^2}{2m}$ である。このとき、 N 個の分子からなる理想気体の分配関数は

$$Z_N = \boxed{\text{(a)}} \times Z_1^{\boxed{\text{(b)}}}$$

となる。 $\boxed{\text{(a)}}$ および $\boxed{\text{(b)}}$ に当てはまる数式を、理由を付けて記せ。

- (3) N 個の分子からなる理想気体に対するヘルムホルツの自由エネルギー $F(T, V)$ 、および内部エネルギーの期待値を求めよ。ただし、 $N \gg 1$ とする。

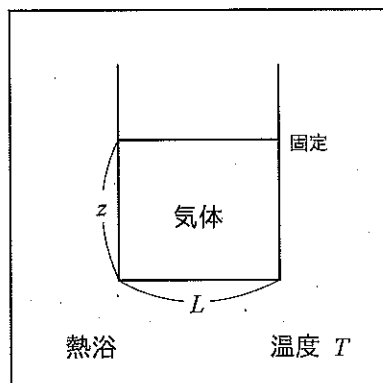


図1

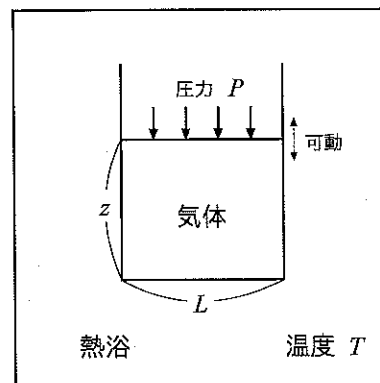


図2

次に、 N 個の単原子分子からなる理想気体を閉じ込めたまま、図 2 のように箱の上面がなめらかに動けるように設定し、その箱を温度 T 、圧力 P の熱浴中に置いて系全体を熱平衡状態にした。箱の高さが z のとき、圧力によるポテンシャルエネルギーは PL^2z で与えられる。このポテンシャルエネルギーを考慮したカノニカル分布より、気体の入った箱の高さが z となる確率分布は

$$f(z) = \frac{1}{Y} Z_N \exp\left(-\frac{PL^2z}{k_B T}\right)$$

で表される。ここで Y は規格化定数である。

- (4) 規格化定数 Y を求めよ。
- (5) $G(T, P) = -k_B T \log Y$ と定義する。 $G(T, P)$ の名称を答え、ヘルムホルツの自由エネルギーとの関係を書け。
- (6) 熱平衡状態における z の期待値を求めよ。

[3] の数学公式

ガウス積分の公式

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-ax^2} = \sqrt{\frac{\pi}{a}}, \quad (a > 0)$$

スターリングの公式

$$\log n! \simeq n \log n - n, \quad (n \gg 1)$$

ガンマ関数

$$\int_0^{\infty} dt t^n e^{-t} = \Gamma(n+1) = n!. \quad (n \text{ は } 0 \text{ または自然数})$$

[4]

プランク定数 h に対して $\hbar = h/2\pi$ とし、また、真空中の光速を c とし、以下の問いに答えよ。なお、必要ならば、問題文の最後にある数学公式を用いてよい。

質量 m の電子が、原点を力の中心としたクーロンポテンシャル

$$V(r) = -\alpha \frac{\hbar c}{r}, \quad \alpha = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\hbar c}$$

の中を運動している。ここで、 r は原点からの距離であり、また、 α は電気素量 e 、真空の誘電率 ϵ_0 、 \hbar および c を用いて構成できる無次元定数である。

この電子の定常状態を表す波動関数を極座標系で $\psi(r, \theta, \phi)$ とする。 $\psi(r, \theta, \phi)$ が満たすシュレーディンガー方程式は、動径運動量演算子 \hat{p}_r および角運動量演算子 \hat{L} を用いて、

$$\left[\frac{(\hat{p}_r)^2}{2m} + \frac{\hat{L}^2}{2mr^2} - \alpha \frac{\hbar c}{r} \right] \psi(r, \theta, \phi) = E\psi(r, \theta, \phi)$$

と表される。ここで、 \hat{p}_r は

$$\hat{p}_r \psi(r, \theta, \phi) = \frac{\hbar}{i} \left(\frac{1}{r} \right) \frac{\partial}{\partial r} \left[r \psi(r, \theta, \phi) \right]$$

で与えられる微分演算子である。

- (1) 質量、長さ、時間の次元をそれぞれ M , L , T で表すとき、ポテンシャルエネルギー V の次元は $[V] = ML^2T^{-2}$ 、角運動量 L の次元は $[L] = ML^2T^{-1}$ と表される。これに習って、 $\hbar c$ の次元を答えよ。
- (2) 波動関数 $\psi(r, \theta, \phi)$ が角運動量の二乗 \hat{L}^2 および角運動量の z 成分 \hat{L}_z の同時固有状態を表すとする。この状態において、 \hat{L}^2 の固有値、および、 \hat{L}^2 がその固有値をとるときに \hat{L}_z がとりうる値の個数を、それぞれ負でない整数 $\ell (= 0, 1, 2, \dots)$ を用いて答えよ。

以下、電子が基底状態にある場合を考える。このとき、 \hat{L}^2 の固有値は 0 であり、また、波動関数を次の形におくことができる。

$$\psi = \frac{u_0(r)}{r}$$

これをシュレーディンガー方程式に代入して整理すると、関数 $u_0(r)$ は次の微分方程式

$$\left[-\frac{1}{2} \lambda^2 \frac{d^2}{dr^2} - \alpha \frac{\lambda}{r} \right] u_0(r) = \left(\frac{E_0}{mc^2} \right) u_0(r)$$

を満たすことがわかる。ここで、 E_0 は基底状態のエネルギー、 mc^2 は電子の静止エネルギーであり、また、 λ は長さの次元をもつ定数である。

(3) 定数 λ を \hbar , m , c を用いて表せ。さらに, 定数 λ の名称を答えよ。

(4) 関数 $u_0(r)$ を次の形に仮定する。ただし, N および b は定数である。

$$u_0(r) = \frac{1}{\sqrt{4\pi N}} r e^{-(r/b)}.$$

この $u_0(r)$ が上記の微分方程式を満たすように定数 b を決定せよ。解答は α や λ を用いて表すこと。また, エネルギー固有値 E_0 が $-\frac{1}{2}\alpha^2 mc^2$ に等しいことを示せ。

(5) 次の規格化条件から, $N = b^3/4$ となることを示せ。

$$1 = \int_0^\infty r^2 dr \int_0^\pi d\theta \int_0^{2\pi} d\phi |\psi(r, \theta, \phi)|^2 = 4\pi \int_0^\infty dr |u_0(r)|^2.$$

(6) 基底状態におけるポテンシャルエネルギーの期待値 $\langle V \rangle$ を計算し, $\langle V \rangle = -\alpha^2 mc^2$ であることを示せ。

(7) 基底状態における動径運動エネルギーの期待値 $\left\langle \frac{p_r^2}{2m} \right\rangle$ とポテンシャルエネルギーの期待値 $\langle V \rangle$ に対して, 次の関係式 (ビリアル定理) が成り立っていることを示せ。

$$2 \left\langle \frac{p_r^2}{2m} \right\rangle = -\langle V \rangle.$$

[4] の数学公式

$$\int_0^\infty dt t^n e^{-t} = \Gamma(n+1) = n!. \quad (n \text{ は } 0 \text{ または自然数})$$